ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Publication number: JP10270172 (A)

Publication date: 1998-10-09

Inventor(s): KIDO JUNJI; MIZUKAMI TOKIO

Applicant(s): KIDO JUNJI; AIMESU KK

Classification:

- international: H01L51/50; C09K11/06; H05B33/22; H01L51/50; C09K11/06; H05B33/22; (IPC1-

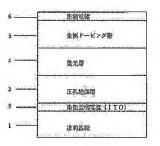
7): H05B33/22; C09K11/06 H01L51/00A6: H01L51/52B4

- European: H01L51/00A6; H01L51/52B4 Application number: JP19970075834 19970327

Priority number(s): JP19970075834 19970327: JP19970012815 19970127

Abstract of JP 10270172 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low driving voltage and highly efficient organic EL element at low costs by providing a light emission layer made of an organic compound between opposing positive and negative electrodes and an organic compound laver doped with metal oxide or metallic salt in a boundary with the negative electrode, SOLUTION: An organic EL element is provided by sequentially stacking a transparent substrate 1 made of glass or the like, a positive transparent electrode 2, a hole transport layer 3, a light emission layer 4 made of a organic compound, a metal doping layer 5 and a negative backside electrode 6. The metal doping layer 5 is obtained by doping an organic compound with metal oxide or metallic salt in a boundary with the negative electrode 6. For this oxide or salt metal, alkaline metal such as Li. alkaline earth metal such as Mg or transition metal containing rare earth metal is preferred. Also, for the doping layer 5 doped with this metal, preferably, dopant concentration is set to 0.1 to 99 wt.% and a thickness is set to 10 to 2000 &angst . Thus, the energy barrier of electron injection from the negative electrode to the organic compound layer is reduced and thereby a low driving voltage is realized.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Family list 5 application(s) for: JP10270172 (A)

1 Organic Electroluminescent devices

Inventor: KIDO JUNJI [JP]; MIZUKAMI TOKIO Applicant: JUNJI KIDO [JP]

Publication info: CN1190322 (A) — 1998-08-12

2 Organic electroluminescent devices

Inventor: KIDO JUNJI [JP]; MIZUKAMI TOKIO

Applicant: KIDO JUNJI [JP]; INT
IJPI

MANUFACTURING AND ENGINEE

[JP] MANUFACTURING AND ENGINEER [JP] EC: H01L51/50G2; H05B33/14 PC: H01L51/50: H01L51/52: H05B33/14: (+3)

Publication info: EP0855848 (A2) — 1998-07-29 EP0855848 (A3) — 1999-02-03

3 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Inventor: KIDO JUNJI ; MIZUKAMI TOKIO Applicant: KIDO JUNJI ; AIMESU KK

Publication info: JP10270171 (A) - 1998-10-09

4 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Inventor: KIDO JUNJI; MIZUKAMI TOKIO Applicant: KIDO JUNJI; AIMESU KK

Publication info: JP10270172 (A) - 1998-10-09

5 Organic electroluminescent devices

 Inventor:
 KIDO JUNJI [JP];
 MIZUKAMI TOKIO
 Applicant:
 KIDO JUNJI [JP];
 INT

 [JP]
 MANUFACTURING AND ENGINEER [JP]

 Ec:
 H01L51/50G2;
 H05B33/14
 FP:
 H01L51/50F;
 H01L51/50F;</td

Publication info: US6013384 (A) - 2000-01-11

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平10-270172

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	FI			
H05B	33/22		H05B	33/22		
C09K	11/06		C09K	11/06	Z	

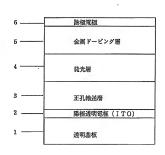
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顯平9-75834	(71)出願人	597011728
			城戸 淳二
(22)出籍日	平成9年(1997) 3月27日		奈良県北高城郡広陵町馬見北9-4-8
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(71)出題人	593191350
(31)優先権主張番号	特願平9-12815		株式会社アイメス
(32)優先日	平9 (1997) 1 月27日		神奈川県藤沢市桐原町 3 番地
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72) 発明者	the management of the state of
(00)	H4- (31)	(12/505/19	奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-8
		(72)発明者	水上 時雄
			神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア
			イメス内
		(74)代理人	弁理士 三浦 邦夫
		(14142)	Maria min Mari

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

(57)【要約】

【目的】 有機足上素子において、整極から有機化合物 層への尾子法人におけるエネルギー障壁を低下させ、陰 部材料の仕事関数に関わらず佐郷前便圧を実現する。 【構成】 陰極電極6に接する有機化合物層を金風酸化 物あるい社会概域でドービングした金属ドーピング層5 とし、膝動施圧を低下させた有機化し素子。 、豚動施圧を低下させた有機と1ま字。



【特許請求の節用】

【請求項1】 対向する陽極電極と陰極電極の間に、有 機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有す る有機エレクトロルミネッセント素子において、上記降 極電極との界面に、金属酸化物または金属塩でドーピン グレた有機化合物層を金属ドーピング層として有するこ とを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の素子において、上記金属 酸化物が、アルカリ金属、アルカリ十類金属、主たは稀 土類金属を含む逐移金属の金属酸化物からなる有機エレ クトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1記載の素子において、上記金属 塩が、アルカリ金属、アルカリ土類金属、稀土類金属を 含む遷移金属の金属塩からなる有機エレクトロルミネッ セント素子。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項記載の素子 において、金属ドーピング層の金属酸化物主たは金属塩 の濃度が、0.1 ~99重量%である有機エレクトロルミネ ッセント素子。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項記載の素子 において、金属ドーピング層の厚さが、10A~2000Aで ある有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか1項記載の素子 において、陰極構成材料の少なくとも一つがアルミニウ ムである有機エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用され る有機エレクトロルミネッセント素子(以下、有機EL素 子) に関するものである。 【従来の技術およびその問題点】発光層が有機化合物か

[0002]

て用いた。

ら構成される有機エレクトロルミネッセント素子(DI 下、有機EL素子) は、低電圧駆動の大面積表示素子を実 現するものとして注目されている。Tangらは幸子の高効 率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物を積層 し、正孔と電子がそれぞれ陽極、陰極よりバランスよく 注入される構造とし、しかも有機層の膜厚が2000 A以下 とすることで、10V 以下の印加電圧で1000cd/m2 と外部 量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を得るこ とに成功した (Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987).)。この高効率素子において、Tangらは基本的に絶縁 物とみなされる有機化合物に対して、金属電極から電子 を注入する際に問題となるエネルギー障壁を低下させる ため、仕事関数の小さいMg(マグネシウム)を使用し た。その際、Mgは酸化しやすく、不安定であるのと、有

機表面に密着性の良いAg(銀)と共蒸着により合金化し 【0003】凸版印刷株式会社のグループ (第51回応

機表面への接着性に乏しいので比較的安定で、しかも有

用物理学会学術講演会、講演予稿集28a-PB-4、p. 1040) およびパイオニア株式会社のグループ(第54回応用物 理学会学術講演会、講演予稿集29p-ZC-15 、p. 1127) は、Mgより更に仕事関数の小さいLi (リチウム) を用い A1 (アルミニウム) と合金化する事により安定化させ险 極として用いることにより、Mg合金を用いた索子より低 い駆動電圧と高い発光輝度を達成している。また、本祭 明者らは有機化合物層上にLiを単独で10Å程度に極めて 薄く蒸着し、その上から銀を積層した二層型陰極が低駆 動電圧の実現に有効であることを報告している (IEEE T rans. Electron Devices., 40, 1342 (1993))

【0004】 最近ではUNIAX 社のPei らが、ポリマー発 光層全体にLi塩を均一にドーピングし、駆動電圧を低下 する事に成功している (Science, 269, 1086 (1995))。これは電圧印加によってポリマー発光層中に均一 分散したLi塩を解離させ、陰極と陽極近傍にそれぞれLi イオンと対イオンを分布させることにより電極近傍のポ リマー分子をin situ でドーピングするものである。こ の場合、陰極近傍のポリマーは電子供与性 (ドナー) ド ーパントであるLiによって還元されたラジカルアニオン 状態で存在するため、除極からの電子注入障壁はLiドー ピングしない場合より極めて低くなる (Science, 269, 1086 (1995)) 。

【0005】さらに最近になって、イーストマン- コダ ック社のHungらはフッ化リチウム(LiF)や砂化マグネ シウム (MgO) などの誘電体を極めて薄く (5~10Å) 電子輸送性有機化合物層と陰極との間に挿入することに より、陰極からの電子注入障壁を低下させ低電圧駆動を 実現している。この二層型陰極を有する素子では、誘電 体が陰極と有機化合物層の間に存在することにより、誘 電体に接する有機化合物のエネルギー準位(バンド構 造) が変化し、陰極からの電子注入が容易になると解釈 されている (Appl. Phys. Lett., 70, 152 (1997)) 。 【0006】しかしながら、MgやLiの合金電極において も電極の酸化等による素子劣化が起こる上、配線材料と しての機能を考慮しなければならないので、合金電極で は電極材料選択において制限を受ける。本発明者もの二 層型陰極では、Li層の厚みが20Å以上では陰極機能した いうえ (IEEE Trans, Electron Devices,, 40, 1342(19 93))、極めて薄い10A程度のLiの蒸着は隙原制御が用 難であり素子作製の再現性に問題がある。また、Pei ら の発光層中に塩を添加して電界にて解離させるin situ ドーピング法では、解離したイオンの電極近傍までの移 動時間が律速となり、素子応答速度が著しく遅くなる欠 点がある。Hungらの二層型陰極においても最適な誘電体 層膜厚が5 Åと極めて薄いため、有機化合物上へ均一な 膜厚を有する誘電体超薄膜層を作製しにくい欠点があ

[0007]

【発明の目的】本発明は、以上の事情に鑑みてなされた

ものであり、その目的は陰極から有機化合物層への電子 注入におけるエネルギー障壁を低下させることにより、 能極材料の仕事開歌に関わら下低駆助電圧を実現するこ とを目的とする。本発明の他の目的は、加の機な健来よ り配線材として一般に用いられてきた安価で安定な金属 を陰極材料として単独で用いた場合でも、上述の合金を 電櫃として用いた場合と同様、若しくはそれ以上の特性 を発現しうる素子を提供することである。

[0008]

【発男の概要】 本発明は、陰極に接する有機化合物層を 金属酸化物あるいは金属塩などの誘電体でドーピングす さと、陰極から有機化合物層への電子注入機能が小さく なり、原動電圧を低下させることができることを見い出 して完成されたものである。すなわち、本発明の有機と 元素子は、対向する陽極電機と陰極電極の間に、有機化 合物から構成される少なくとも一層の発光度を有するEL 来子において、陰極電極との界面に、金属酸化物あるい は金属塩でドーピングした有機化合物層を有することを 特徴としている。

[0009]

【発明の実施の形態】図1は、本発明による有機EL素 子の一実施形態を示す模式図である。ガラス基板(透明 基板) 1上には、順に、陽極電極を構成する透明電極 2、正孔輸送性を有する正孔輸送層3、発光層4、金属 ドーピング層5および陰極となる背面電極6を積層して なっている。これらの要素(層)のうち、ガラス基板 (透明基板) 1、透明電極2、正孔輸送層3、発光層 4、および陰極電極6は周知の要素であり、金属ドービ ング層 5 が本発明で提案した要素 (層) である。有機配 素子の具体的な暗層構成としては、この他、陽極/発光 層/金属ドーピング層/除極、陽極/正孔輸送層/発光 層/金属ドーピング層/陰極、陽極/正孔輸送層/発光 眉/電子輸送層/金属ドーピング層/陰極、陽極/正孔 注入層/発光層/金属ドーピング層/陰極、陽極/正孔 注入層/正孔輸送層/発光層/金属ドーピング層/陰 極、陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/金属ドーピング層/陰極、などが挙げられるが、本 発明による有機EL率子は、金属ドーピング層5を除極 電極6との界面に有するものであればいかなる素子構成 であっても良い。

【0010】図2は、陰極電極6と有機発光層4との間 に電子輸送層8が存在し、この電子輸送層2と接て電極 の界面に金属ドーピング層5が設けられている例を示 している。金属ドーピング層5は、有機化物中に誘電 体である金属酸化物や金属塩がドーパントとして存在し ており、このため、ドーパントに接する有機分子のパン ド構造が変化し、LUBO等位が下がる。この結果、陰極か の電子性入が容易になる。

【0011】図3は、比較のために、Hungらの提案した 従来の有機比素子の陰極界面部分を示している。この例 は結電体標度原9 を陰恒電極 0 と電子輸送圏 8 との非面 に有する場合であるが、この添子では誘電体に接する陰 纒界面近婚の有機化合物の水シド精造が膨化し、電子が 注入される有能化合物の最低空準位 (LIMO) が低下し、 能極からの配子主入が容易となると言われてきたが、本 発明による有機阻素子では、図3の従来の陰極界画構造 に比較して、さらに陰極からの電子注入が容易となり、 駆動鏡狂を低下させることができる。

【0012】有機旺素子では陰極から基本的に絶縁物で ある有機化合物層への電子注入過程は、除極表面での有 機化合物の還元、すなわちラジカルアニオン状態の形成 である (Phys. Rev. Lett., 14, 229 (1965)) 。これは すなわち有機化合物の最低空準位 (LUMO) への電子注入 である。したがって、LUMO準位の低い有機化合物ほど陰 極から電子が注入しやすい。本発明の素子においては、 予め有機化合物のLUMOを低下させる効果のある金属酸化 物あるいは金属塩を陰極に接触する有機化合物層中にド ーピングする事により、陰極電極からの電子注入に際す るエネルギー障壁を低下させることができる。金属ドー ピング層5は、このように金属酸化物あるいは金属塩か らなるドーパント物質をドーピングした有機化合物層で ある。金属ドーピングした有機化合物は先に述べたよう にLUMO準位が低くなるので、陰極からの電子注入エネル ギー障壁が小さく、従来の有機比素子と比べて駆動電圧 を低下できる。しかも陰極には一般に配線材として用い られている安定なA1のような金属を使用できる。

【0013】ドーパントはホストとなる有機化合物の電 ケエネルギー準位を変化させ、LUM0準位を低下させるこ とのできるLi等のアルカリ金属、Mi等のアルカリ土類金 属、あるいは硝土類金属を含む運移金属の金属酸化物や 金属塩であれば特に限定はないが、金属酸化物の場合 は、LiQ、NaQ、KQ、Ro Rog Cad Nag Cad など、 金属塩の場合はLiF、NaF、KF、RoF、CaF、NaF、Ca F、SrF、BaF、LiCl、NaCl、KCl、RbCl、CaCl、MgCl 2、CaCl、SrCl、、BaCl、などを好適に用いることが できる。

【0014】金属ドーピング層5のドーパント濃度は特に限定されないが、0.1~99重量%であることが好ましい。0.1重視外表前には、ドーパントの遊皮が低すぎドーピングの効果が小さく、99重量%を超えると、腰中のドーパント濃度が高過ぎ、陰極近傍で電子が注入されるべき有機化合物濃度が逆に低すぎるので、ドーピングの効果が下がる。また、この金属ドーピング側の厚かは、特に限定されなが10人~2000人が好ましい。1人未満では、金属ドーピング層の厚厚が背すぎ、均一な腰が得られにいうえ、電子が注入されるべき1LMの壁位の下がった有機分子の量が少なすぎる。また、2000人を超えると有機間全体の膜厚が呼すぎ、逆に駆励電圧の上昇を招くので好ましくない。

【0015】上記金属ドーピング層5の成膜法は、いか

なる専鵬形成法であってもよく、たとえば霧着法やスパック法が使用できる。また、溶液からの塗布で調暖形成 が可能な場合には、スピンコーティング性やディップコーティング生などの溶液からの整布法が使用できる。この場合、ドーピングされる有機化合物とドーパントを不活性なポリーマー中に分散して用いても良い。

【0016】発光層、電子輸送層、金属ドーピング層と して使用できる有機化合物としては、特に限定はない が、pーテルフェニルやクアテルフェニルなどの多環化合 物およびそれらの誘導体、ナフタレン、テトラセン、ピ レン、コロネン、クリセン、アントラセン、ジフェニル アントラセン、ナフタセン、フェナントレンなどの縮合 多環炭化水素化合物及びそれらの誘導体、フェナントロ リン、パソフェナントロリン、フェナントリジン、アク リジン、キノリン、キノキサリン、フェナジンなどの締 合複素環化合物およびそれらの誘導体や。フルオロセイ ン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペ リノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニ ルプタジエン、テトラフェニルブタジエン、オキサジア ゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチ リル、ピラジン、シクロペンタジエン、オキシン、アミ ノキノリン、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアン トラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラ ン、ポリメチン、メロシアニン、キナクリドン、ルブレ ン等およびそれらの誘導体などを挙げることができる。 【0017】また、特開昭63-295695 号公報、特開平8-22557 号公報、特開平8-81472 号公報、特開平5-9470号 公報、特開平5-17764 号公報に開示されている金属キレ ート錯体化合物、特に金属キレート化オキサノイド化合 物では、トリス (8-キノリノラト) アルミニウム、ビス (8-キノリノラト) マグネシウム、ビス [ベンゾ (f) -8- キノリノラト] 亜鉛、ビス (2-メチル-8- キノリノ ラト) アルミニウム、トリス (8-キノリノラト) インジ ウム、トリス (5-メチル-8- キノリノラト) アルミニウ ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロ-8-キ ノリノラト) ガリウム、ピス(5-クロロ-8- キノリノラ ト) カルシウムなどの8-キノリノラトあるいはその誘導 体を配位子として少なくとも一つ有する金属錯体が好適 に使用される。

【0018】特開平5-202011多公報、特開平7-17934号公報、特開平7-278124号公報、特開平7-228579号公報に開示されているオサジアソール類、特開平7-157473号公報に開示されているトリアジン類、特開平6-203963号公報に開示されているスチルペン誘導体およびジスチリルアリーレン誘導体、特開平6-18072号公領に開示されているスチリル協議体、特開平6-100857号公報や特開平6-07170号公領に開示されているジオレフィン誘導体も発光層、電子輸送層、金属ドーピング層として好ましい。

【0019】さらに、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチ

アゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤も 使用でき、例えば、特開昭59-194393 号公報に開示され ているものが挙げられる。その代表例としては、2.5-ビ ス (5.7-ジ-t- ベンチル-2-ベンゾオキサゾリル) -1.3. 4- チアゾール、4,4'- ピス (5,7-t-ペンチル-2- ベン ゾオキサゾリル) スチルベン、4,4'- ビス [5,7-ジー (2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオキサゾリル] スチ ルベン、2.5-ビス (5.7-ジ-t- ペンチル-2- ベンソオキ サゾリル) チオフェン、2,5-ビス [5- (α, α- ジメチ ルベンジル) -2-ベンゾオキサゾリル] チオフェン、2.5 -ビス [5,7-ジー (2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオ キサゾリル] -3,4- ジフェニルチオフェン、2,5-ビス (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) チオフェン、4.4' - ビス (2-ベンゾオキサゾリル) ビフェニル、5-メチル -2- {2- {4- (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) フェ ニル] ビニル} ベンゾオキサゾール、2- [2-(4-クロロ フェニル) ビニル] ナフト (1,2-d)オキサゾールなどの ベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレンジピニレ ン)-ビスベンゾチアゾールたどのベンゾチアゾール系 2- {2- [4- (2-ベンゾイミダゾリル) フェニル] ビニ ル ペンゾイミダゾール、2-「2-(4-カルボキシフェニ ル) ビニル] ベンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾ ール系などの蛍光増白剤が挙げられる。

【0020】ジスチリルベンゼン系化合物としては、何 えば欧州特幹第037882 号明細書に開始されているもの を用いることができる。その代表例としては、1,4-ビス (2-メチルスチリル)・ベンゼン、1,4-ビス (3-メチルス チリル)・ベンゼン、1,4-ビス (2-エチルステリル)・ベン ゼン、ジスチリルベンゼン、1,4-ビス (2-エチルステリル)・ベンゼン、1,4-ビス (2-エチルステリル)・ベンゼン、1,4-ビス (2-エチルスチリル)・ベンゼン、1,4-ビス (2-メチルスチリル)・2- メチルベンゼン などが挙げられる。

[0021]また、特開平の-252795名公線に開示されているジスチリルビラジン誘導体も発光層、電子輸送層、金属ドービング層として用いることができる。その代表例としては、2,5ーピス (4-エチルスチリル) ビラジン、2,5ーピス (4-エチルスチリル) ピラジン、2,5ーピス (4-メトキシスチリル) ピラジン、2,5ーピス [2-(4-ピフェニル) ピラジン、2,5ーピス [2-(4-ピフェニル) ピニル] ピラジンなどが挙げられる

[0022] その他、欧州特特第38768号明邮幣や特別 写る-231970号公報に開示されているジメチリティノ前導 体を発光層、能子輸送層、金属ドーピング層の材料として て用いることもできる。その代表例としては、1,4-フェ ニレンジメチリディン、4,7 フェニレンジメチリディン、2,6-キシリレンジメチリディン、2,6-キシリレンジメチリディン、2,6-オリテレンジ メチリディン、1,4-ピフェニレンジメチリディン、1,4 アテレフェニレンジメチリディン、9,10-アントラキン

ジイルジメチリディン、4.4'-(2.2-ジ-t-プチルフェ ニルビニル) ビフェニル、4,4'-(2,2-ジフェニルビニ ル) ビフェニル、など、及びこれらの誘導体や、特別平 6-49079 号公報、特開平6-293778号公報に開示されてい るシラナミン誘導体、特開平6-279322号公報、特間平6-279323号公報に開示されている多官能スチリル化合物。 特開平6-107648号公報や特開平6-92947 号公報に開示さ れているオキサジアゾール誘導体、特開平6-206865号公 報に開示されているアントラセン化合物、特開平6-1451 46号公報に開示されているオキシネイト誘導体、特開平 4-96990 号公報に開示されているテトラフェニルプタジ エン化合物、特開平3-296595号公報に開示されている有 機三官能化合物、さらには、特開平2-191694号公報に開 示されているクマリン誘導体、特開平2-196885号公報に 開示されているペリレン誘導体、特開平2-255789号に開 示されているナフタレン誘導体、特開平2-289676号及び 特開平2-88689 号公報に開示されているフタロペリノン 誘導体、特開平2-250292号公報に開示されているスチリ ルアミン誘導体などが挙げられる。さらに、従来有機匹 素子の作製に使用されている公知のものを適宜用いるこ とができる。

【0023】正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光 層として使用されるアリールアミン化合物類としては、 特に限定はないが、特開平6-25659 号公報、特開平6-20 3963号公報、特開平6-215874号公報、特開平7-145116号 公報、特開平7-224012号公報、特開平7-157473号公報、 特開平8-48656 号公報、特開平7-126226号公報、特開平 7-188130号公報、特開平8-40995 号公報、特開平8-4099 6 号公報、特開平8-40997 号公報、特開平7-126225号公 報、特開平7-101911号公報、特開平7-97355 号公報に開 示されているアリールアミン化合物類が好ましく、例え ば、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノフェニ ル、N, N' - ジフェニル-N, N' -ジ (3-メチルフェニル) -4,4'-ジアミノビフェニル、2,2-ビス (4-ジ-p- トリル アミノフェニル) プロパン、N.N.N'.N'-テトラ-p- トリ ルー4、4'ージアミノビフェニル、ビス (4-ジ-b- トリルア ミノフェニル)フェニルメタン、N,N-ジフェニル-N, N'-ジ (4-メトキシフェニル) -4,4'-ジアミノビフェニ ル、N.N.N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノジフェニ ルエーテル、4.4'- ビス (ジフェニルアミノ) クオード リフェニル、4-N, N-ジフェニルアミノ- (2-ジフェニル ビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N,N-ジフェニルアミ ノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール、1.1-ビス (4- ジ-p- トリアミノフェニル) - シクロヘキサン、 1.1-ビス (4-ジ-p-トリアミノフェニル) -4- フェニル シクロヘキサン、ビス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフ ェニル) - フェニルメタン、N.N.N-トリ (p-トリル) ア ミン、4- (ジ-p- トリルアミノ) -4'- [4 (ジ-p- トリ ルアミノ)スチリル]スチルベン、N,N,N',N'-テトラーD - トリル-4,4'-ジアミノ- ピフェニル、N,N,N',N'-テト

ラフェニル-4.4'-ジアミノ- ビフェニルN-フェニルカル バゾール、4.4'- ビス 「N- (1-ナフチル) -N- フェニル - アミノ] ビフェニル、4.4''-ビス [N-(1-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] p-ターフェニル、4.4'- ビス [N- (2-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニ ル、4,4'- ビス [N- (3-アセナフテニル) -N- フェニル - アミノ] ビフェニル、1,5-ビス [N- (1-ナフチル) -N - フェニル- アミノ] ナフタレン、4,4'- ビス [N- (9-アントリル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4. 4''-ビス [N- (1-アントリル) -N- フェニル- アミノ] p-ターフェニル、4,4'- ビス [N- (2-フェナントリル) -N- フェニル- アミノ] ピフェニル、4.4'- ビス [N-(8-フルオランテニル) -N- フェニル- アミノ] ビフェ ニル、4,4'-ビス [N- (2-ピレニル) -N- フェニル- ア ミノ] ピフェニル、4,4'- ビス [N- (2-ペリレニル) -N - フェニル- アミノ] ビフェニル、4,4'- ビス [N- (1-コロネニル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、2.6-ピス (ジ-p- トリルアミノ) ナフタレン、2,6-ビス [ジ - (1-ナフチル) アミノ] ナフタレン、2,6-ビス [N-(1-ナフチル) -N- (2-ナフチル) アミノーナフタレ ン、4.4''-ビス [N,N-ジ (2-ナフチル) アミノ] ターフ エニル、4.4'- ビス (N-フェニル-N- [4- (1-ナフチ ル) フェニル] アミノ} ビフェニル、4.4'- ビス [N-フ エニル-N- (2-ピレニル) - アミノ] ビフェニル、2.6-ビス [N, N-ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4. 4''- ビス (N, N-ジ-p- トリルアミノ) ターフェニル、 ビス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミンなどがあ る。さらに、従来有機比素子の作製に使用されている公 知のものを適宜用いることができる

【0026】陰極電極には、空気中で安定に使用できる 金属であれば限定はないが、特に配線電極として一般に 広く使用されているアルミニウムが好ましい。

【0027】 [実施例] 以下に実施例を挙げて本発明を 説明するが、本発明はこれにより限定されるものではな い。なお、有機化合物および金属の蒸着には、真空機工 社製炉で400 真空蒸着機を使用した。 際原の測定はスロ ーン社製DekTak3ST 触針式酸差計を用いた。素子の特性 評価には、糖水PBX 40-2.6還流電源、岩道V0AC-7510 マ ルチメーター、トプコンB+で成実計を使用した。素子の ITO を陽極、A1を陰極として直流電圧を0.5 V/2 秒あ るいは1 V/2 秒の割合でステップ状に印加し、電圧上 月1 秒後の原理なお「電流電を測定した。また、DLスペ クトルは浜松ホトニクスPIM-10オプチカルマルチチャン ネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定した。 [0 0 2 81 実施例1

図1の額層構成の有機见素子に本発明を適用したもので ある。ガラス基板1上に、陽極透明電極2として、シー ト抵抗150/口のITO (インジウムースで配化物、旭硝 子社製電子ビーム蒸着品)がコートされている。その上 に正孔輸送性を有する下配式1:

【化1】

で表されるαPD を10⁴torr下で、3 A/秒の蒸着速度 で400 Aの厚さに成態し、正孔輸送層3を形成した。 [0029] 次に、前記正孔輸送層3の上に、発光層4 として緑色発光を有する下記式2: [化2]

で表されるトリス(8-キノリノラト)アルミニウム鈴体層(以下「Ald」という)4を3と同じ条件で600人であた。 次に、前原発光層 4の上に金属ドービング層5として、Alq とLiF をLiF が2重 景%となるように各々の素物速度を開整して100人成態した。 最後に、前記金属ドービング層50上に機械となる背面電極6としてAlを高率速度15人/砂で1000人蒸落した。 発光循環は縦0.5cm 、横0.5cm の正方形状とした。 前記の有機肛条子において、陽極電極であるITOと陰極極症をあるIf 6との間に、直流電圧を印加し、発光層和44からの緑色発光の環度を測定した。この楽子からは15000cd/m の高頻度を13Vにおいて示した。このときの電流密度は440m/cm であった。

[0030]比較例1

実施例1と同じく、ITO 上にまず正孔輸送層としてαNP

Dを400 Aの厚さに成腰し、その上に、発光層としてAI 東 を3と同じ条件で600 Aの厚さに真空落着して形成し た。そして、AIq の上から除極としてAIを2000A蒸着し た。この素子では157 で最高6700cd/m の輝度しか与え ず、輝度の向上と駆動履圧を下げるのに金属ドーピング 層5が有効であることがわかる

【0031】比較例2

実施例1と同条件で、ITO 上にまず正孔輸送層としてα NPD を400 Aの厚さに成膜し、その上に、Alq を500 A 条着した後に、Lif のみを100 Aの厚さに英空無着して形成し、その上から陰極としてAlを2004無着した。この案子では電流が全く住入されず、素子からの発光が観測されなかった。これはLif のみ100 A 挿入したのではLif 層が完全な絶縁体層であるため、陰極からの電子柱入が行われなかったと思われる。したがって、Lif が10 A の場合には陰極に接する部分には電子ដ入のために有機分子が必要であるととを示している。

【0032】実施例2

ROUS 21 突鳴例2 摩さ 1 mmの若葉ガラス上に、Alq とLiF をLiF が 2 重量 %となるように各々の蒸着池度を開整して1000A成膜し た。また、Alq のみを蒸着して1000A成膜した試料も作 製した。これらの可視紫外吸収ペクトルにおいて、Al q のみを蒸着した膜ではキノリン環による吸収が400mm 付近に見られたが、LiF をドーピングしたAlq 膜ではこ のようなキノリン環による強い吸収が375mm に見られ た。これれ上げがAlq 分平の近傍に存在することでAlq 分子のエネルギー準位が変化していることを表してい

【0033】実施例3

170 上に、正孔輸送層 3 としてα NPD を400 A、発光層 4 としてAIQ を600 A 東空蒸着した後、AIQ と酸化リチウム (LiQ) を金属 ドーピング層 5 としてLiQ歳疾が3 起劣となるよう100 Aの厚みに共蒸着した。その上から、陰極電極 6 として、AIを1000 A蒸着し来子を作製した。この素子は印加電圧 1 3 Vで最高輝度16000c/m と 電流密度480mA/cm を与え、実施例1と同じく、低い駆 動電圧で高度度を与えた。

[0034]比較例3

実施例1と同条件で、ITO 上にまず正孔輸送層として α NFD を400 A の厚きに成膜し、その上に、Alq を600 A 条着 た後後に、LiQのみを100 A の厚きに度変素して形成し、その上から陰極としてAlを2000 A 落着した念に、の素子では電流が全く往入されず、発光は緩緩されたかった。これはLiQのみ100 A 挿入したのではLiQ局が完全な絶縁体層であるため、陰極からの電子を入が行われなかったと思われる。したがって、金属ドーピング層には電子往入のために有機化合物との共蒸着が必要不可欠であることを示している。

[0035] 実施例4

ITO 上に、正孔輸送層3としてαNPD を400 Å、発光層

4としてAlq を500 A真空旅着した後、バソフェナント ロリンとLi,0を金属・ビング層 5 としてLi,0が 3 重量 %となるように100 Aの厚ふに共無着した。その上か ら、陰極電極 6 としてAlを1000 A蒸着し業子を作製し た。この業子は印加電圧137で最高輝度21000c4/m。電 流密度550m4/cm。をき、実施例 1 と同じく、低い駆動 電圧で高粱度を与えた。

[0036]

【発明の効果】以上の如く、本発明の有機四票子は、金 風酸化物と金属塩の少なくとも一方によってドーピンの した有機化合物質 (金属 ドーピング層) を接極電極との 界面に設けることによって、駆動電圧が低く、高効率、 調節度男光端子の作製を可能にした。したがって、本発 順の有機加票がは、実用後が高く、表示素子や整盤とし

[図1]

ての有効利用を期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機比素子の積層構造例を示す模式断面図である。

【図2】本発明の有機LL素子の陰極部分を示す説明図である。

【図3】従来の有機比素子の陰極部分を示す説明図である。

【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 陽極透明電極
- 4 発光層
- 5 金属ドーピング層
- 6 陰極電極

